

اثر نقاط جانبی بر هدایت میان ترکیبات چهار نقطه کوانتومی:

مطالعه با روش تابع گرین غیرتصادلی

زهره داریزین، میثم باقری و حمید رحیم پور سلیمانی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

(دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۳/۱۹؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۴/۹/۹)

چکیده

انتقال الکترونی در ترکیبات چهار نقطه کوانتومی جفت شده به الکترودهای فلزی با استفاده از روش تابع گرین غیرتصادلی بررسی و نمودارهای $I-V$ و هدایت (dI/dV) برای ترکیباتی خاص، تحلیل می‌شود. نشان می‌دهیم که ظهور هدایت دیفرانسیل منفی، به علت توزیع نامتقارن نقاط در ناحیه مرکزی و جفت نبودن برخی از نقاط به الکترودها (نقاط کوانتومی جانبی) و ایجاد اثر تداخل می‌باشد. در می‌یابیم که وجود نقاط کوانتومی جانبی بیشتر، هدایت دیفرانسیل منفی بیشتری را موجب می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نقاط کوانتومی، انتقال، تابع گرین غیرتصادلی، هدایت منفی

۱. مقدمه

به هادی‌ها، می‌تواند اتفاق بیفتد [۸-۱۱]. از کاربردهای آن در تقویت‌کننده و نوسانگر در میکروموج، میلی‌موج و محدوده‌های بسامد تراهرتز می‌باشد [۱۲]. ما در این مقاله با بررسی انتقال الکترونی و هدایت از میان ترکیبات چهار نقطه کوانتومی جفت‌شده به الکترودهای فلزی در حالت‌های اتصال متقارن و نامتقارن با استفاده از روش تابع گرین غیرتصادلی، به ظهور هدایت دیفرانسل منفی دست می‌یابیم. در ابتدا روش کار،

انتقال الکترونی میان دستگاه‌های نقطه کوانتومی جفت شده، در طول دهه گذشته، عنوان مهمی برای تحقیقات نظری و تجربی بوده است [۱-۴]. از جمله پدیده‌های کشف شده، پله‌ای بودن تغییرات جریان-ولتاژ $(I-V)$ [۵]، نوسان سد کلونی [۶]، هدایت دیفرانسیل منفی [۷]، است. هدایت دیفرانسیل منفی در ترکیبات نقطه کوانتومی چندگانه، در جفت شدگی‌های متفاوت

به علت درگیر نبودن میدان مغناطیسی حذف شده است. فرض شده است که هر نقطه کوانتومی یک تراز انرژی دارد. از برهم کنش های الکترون- الکترون صرف نظر شده است. جریان در حالت پایا در یک کانال اسپینی از رابطه زیر به دست می آید:

$$I_S = \frac{e}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} dE (f_L - f_R) T_S(E),$$

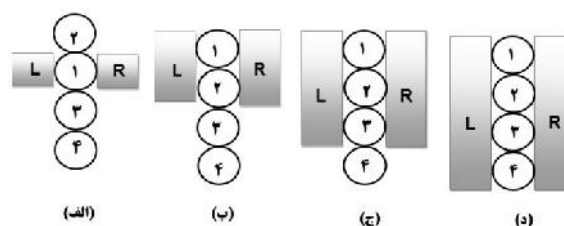
روابط ضریب عبور و هدایت به این صورت نوشته می شود:

$$T_d(E) = \text{Tr} [\Gamma_d^L G_d^r \Gamma_d^R G_d^a].$$

$$G = dI / dV.$$

بیانگر تابع فرمی در دو الکترون راست و چپ است، که $m_{L,R}$ پتانسیل های شیمیایی در هر الکترون هستند. Γ^L و Γ^R ماتریس های قدرت جفت شدگی بین الکترون و ناحیه مرکزی در دو طرف چپ و راست اند، که می توانند همانند یک ماتریس ثابت عمل کنند و در محاسبات مقدار ورودی برای آنها در نظر گرفته شود. G^r و G^a توابع گرین تأخیری و پیشرفته اند: $G^a = (G^r)^\dagger$ با استفاده از نظریه تابع گرین غیرتعادلی و اعمال روش معادله حرکت تبدیل فوریه، این توابع گرین به شکل ماتریسی $G_S^r(E) = [E - H_C - \sum_s^r(E)]^{-1}$ نوشته می شود [۱۳].

محاسبات را در دمای صفر انجام می دهیم. می توانیم واحد انرژی E_0 را طوری تنظیم کنیم که بالاترین سطوح انرژی در نقاط کوانتومی باشد. پتانسیل های شیمیایی در دو الکترون $m_L = V$ ، $m_R = 0$ تنظیم شده است. مسیر حرکت الکترون ها از الکترون چپ به راست است. اعمال ولتاژ به صورت یکنواخت انجام شده است. برای بررسی اثرات نقطه های کوانتومی جانبی بر دستگاه، در چهار مرحله با در نظر گرفتن ترکیبات چهار نقطه کوانتومی که به الکترون های فلزی متصل شده اند، در نظر گرفته شده است (شکل ۱). در هر یک از حالات در نظر گرفته شده، نمودار جریان بر حسب ولتاژ و نمودار هدایت بر حسب ولتاژ رسم می شود. بررسی اثرات نقطه های کوانتومی جانبی در انتقال الکترونی و توزیع هدایت در هر حالت به شکل مجزا بررسی شده است.



شکل ۱. چهار حالت از ترکیبات چهار نقطه کوانتومی جفت شده به الکترون های فلزی در دمای صفر.

توضیح و روابط مورد نیاز را معرفی و سپس در چهار حالت از ترکیب چهار نقطه کوانتومی به بررسی اثرات نقطه های کوانتومی جانبی پرداخته و نمودارها، تحلیل ها و نتایج به دست آمده را بیان می کنیم. در انتها نتیجه گیری ارائه می شود.

۲. طرح و روش کار

طرح مورد بررسی شامل دو الکترون (الکترون راست (R) و الکترون چپ (L) و ناحیه مرکزی (C)) است. ناحیه مرکزی شامل ترکیبات مختلف نقاط کوانتومی است که به الکترون ها جفت شده اند. هامیلتونی کل به این شکل نوشته می شود:

$$H = H_{L,R} + H_C + H_T,$$

$$H_{L,R} = \sum_{k,a \in (L,R), d} e_{k,a} c_{k,a,d}^\dagger c_{k,a,d},$$

$$H_C = \sum_{j,d} e_j d_{j,d}^\dagger d_{j,d} + \sum_{i,j,d} (t_{i,j} d_{i,d}^\dagger d_{j,d} + H.c.), \quad (1)$$

$$H_T = \sum_{k,a \in (L,R), d} (V_{k,a,d} c_{k,a,d}^\dagger d_{j,d} + H.c.)$$

که در آن $(c_{k,a,d}, d_{j,d}^\dagger, c_{k,a,d}^\dagger, d_{j,d})$ عملگرهای خلق الکترون (نابودی الکترون) به ترتیب در الکترون ها و ناحیه مرکزی هستند. N تعداد کل نقاط کوانتومی درون ناحیه مرکزی می باشد. $a \in L, R$. مشخصه الکترون چپ و الکترون راست است. $e_{k,a}$ ، e_j بیانگر طیف های پیوسته انرژی در الکترون ها و سطوح گسسته انرژی در j امین نقطه کوانتومی است. $t_{i,j}$ ضریب جفت شدگی بین i امین و j امین نقطه کوانتومی و $V_{k,a,j}$ قدرت تونل زنی بین j امین نقطه کوانتومی و الکترون ها می باشد. شاخص اسپین σ در سطوح انرژی و ضرایب جفت شدگی

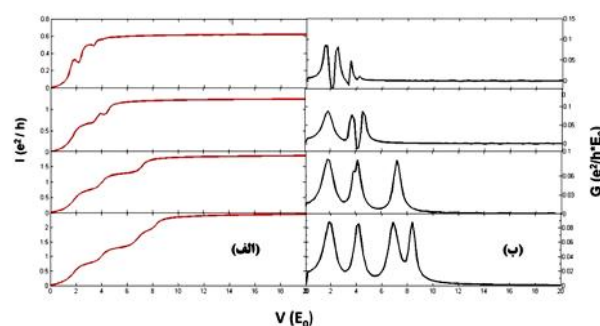
راست ۲- ورود به نقطه کوانتومی دوم ۳- ورود به نقطه کوانتومی سوم. وقتی با تغییر ولتاژ، سطح پتانسیل شیمیایی الکتروود چپ برابر با سطح تراز انرژی نقطه کوانتومی دوم شود ($mL = V = E_2 = 2$)، یعنی در $V = 2$ ، الکترون مسیر ورود به نقطه دوم را انتخاب کرده، ولی به علت متصل نبودن نقطه دوم به هیچ الکتروود و نقطه‌ای، الکترون در این نقطه به دام می‌افتد و اثر ضد تشدید رخ می‌دهد، که موجب افت لحظه‌ای جریان و ایجاد دره در نمودار $I-V$ می‌شود. هنگامی که سطح پتانسیل شیمیایی الکتروود چپ برابر با سطح تراز انرژی نقطه کوانتومی سوم شود ($mL = V = E_3 = 3/5$)، الکترون مسیر ورود به نقطه سوم را انتخاب کرده و اثر ضد تشدید و دره دوم رخ می‌دهد. وقوع هر پله در نمودار $I-V$ موجب یک قله در نمودار هدایت می‌شود. در محدوده ولتاژی که جریان مقدار ثابتی است و به حالت اشباع رسیده، هدایت صفر می‌باشد. نابرابر بودن توزیع قله‌ها و دره‌ها در نمودار هدایت به علت توزیع نامتقارن نقاط کوانتومی در اتصال به الکتروودها و در واقع حضور سه نقطه کوانتومی جانبی در ناحیه مرکزی است.

حال در مرحله دوم، نقاط به گونه‌ای به یکدیگر جفت شده‌اند که از چهار نقطه کوانتومی در ناحیه مرکزی، دو نقطه به الکتروودهای راست و چپ متصل شده‌اند (شکل ۱ (الف)). در این صورت خواهیم داشت:

$$E_1 = 1 + V/2, \quad E_2 = 2 + V/2, \quad E_3 = 3/5, \quad E_4 = 4$$

در این حالت به علت ایجاد دو تراز مؤثر، نمودار $I-V$ از حالت تک‌پله‌ای به دوپله‌ای تبدیل می‌شود (شکل ۲ (الف)). هنگامی که الکترون وارد نقطه کوانتومی دوم می‌شود، سه مسیر برای ادامه حرکت پیش می‌آید. وقتی سطح پتانسیل شیمیایی الکتروود چپ برابر با سطح تراز انرژی نقطه کوانتومی سوم شود ($mL = V = E_3 = 3/5$)، الکترون وارد این نقطه می‌شود. یعنی در ولتاژ $3/5$ اثر ضد تشدید و در نتیجه دره در نمودار دو پله‌ای جریان ایجاد می‌شود. در حالت اول و دوم در ولتاژهایی که جریان افت می‌کند، مشتق آن نسبت به ولتاژ منفی و در نتیجه اثر هدایت دیفرانسل منفی رخ می‌دهد.

در مرحله سوم، از چهار نقطه کوانتومی متصل به هم در



شکل ۲. (الف) نمودار جریان برحسب ولتاژ در چهار حالت از ترکیب چهار نقطه کوانتومی. (ب) نمودار هدایت برحسب ولتاژ در چهار حالت از ترکیب چهار نقطه کوانتومی جفت شده به الکتروودهای فلزی.

۳. بحث و نتایج

در ترکیبات مورد بررسی، ماتریس‌های جفت شدگی و H_C به صورت ماتریس‌های ۴ در ۴ نوشته می‌شود.

$$\Gamma_{L(R)} = \begin{bmatrix} \Gamma_{L(R)1} & \Gamma_{L(R)12} & \Gamma_{L(R)13} & \Gamma_{L(R)14} \\ \Gamma_{L(R)21} & \Gamma_{L(R)2} & \Gamma_{L(R)23} & \Gamma_{L(R)24} \\ \Gamma_{L(R)31} & \Gamma_{L(R)32} & \Gamma_{L(R)3} & \Gamma_{L(R)34} \\ \Gamma_{L(R)41} & \Gamma_{L(R)42} & \Gamma_{L(R)43} & \Gamma_{L(R)4} \end{bmatrix},$$

$$H_C = \begin{bmatrix} E_1 & t_{12} & t_{13} & t_{14} \\ t_{21} & E_2 & t_{23} & t_{24} \\ t_{31} & t_{32} & E_3 & t_{34} \\ t_{41} & t_{42} & t_{43} & E_4 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{L(R)} ii = \Gamma_{L(R)} i = 0, \quad i = j, \quad \Gamma_{L(R)} ij = 0, \quad i \neq j.$$

ضرایب t_{ij} با توجه به نحوه اتصال نقاط کوانتومی به یکدیگر مقدار می‌گیرند. اگر نقاط به یکدیگر متصل باشند مقدار $0/3$ - و در غیر این صورت برابر صفر است.

در اولین مرحله، چهار نقطه کوانتومی در ناحیه مرکزی به گونه‌ای به یکدیگر جفت شده‌اند که تنها یک نقطه به دو الکتروود چپ و راست متصل شده‌اند (شکل ۱ (الف)). در این حالت، سطوح تراز انرژی نقاط به صورت زیر تنظیم می‌شوند. $E_1 = 1 + V/2, E_2 = 2 + V/2, E_3 = 3/5, E_4 = 4$ به علت اتصال تنها یک نقطه کوانتومی در ناحیه مرکزی به دو الکتروود راست و چپ و ایجاد تنها یک تراز مؤثر، روند افزایشی جریان برحسب ولتاژ به صورت تک‌پله‌ای است (شکل ۲ (الف)). هنگامی که الکترون وارد نقطه کوانتومی ۱ می‌شود، سه مسیر برای ادامه حرکت ایجاد می‌شود (پدیده تداخل): ۱- ورود به الکتروود

در حالت چهارم، به علت توزیع متقارن هر چهار نقطه کوانتومی، قله‌های هدایت برابرند و هیچ ناهمگونی در روند تغییرات هدایت ایجاد نمی‌شود (شکل ۲ (الف) و (ب) (۴)).

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله با بررسی انتقال الکترونی از میان ترکیبات چهار نقطه کوانتومی با روش تابع گرین غیرتعادلی، تغییرات جریان با افزایش ولتاژ و توزیع هدایت (dI/dV) تحلیل شده است. با بررسی هدایت در حالت‌های در نظر گرفته شده، می‌توان به این نتیجه رسید که عدم تقارن در توزیع نقاط کوانتومی و وجود نقاط جانبی در ناحیه مرکزی موجب ظهور هدایت دیفرانسیل منفی و همچنین بیشتر شدن عدم تقارن و نقاط جانبی، دلیلی بر بیشتر شدن هدایت دیفرانسل منفی می‌باشد. تقارن در اتصال نقاط کوانتومی و عدم وجود نقاط جانبی در ناحیه مرکزی، تقارن در توزیع هدایت را به دنبال دارد.

ناحیه مرکزی، سه نقطه کوانتومی به الکترودهای چپ و راست جفت شده شکل ۱ (۳) و در حالت چهارم، هر چهار نقطه به الکترودها متصل‌اند (۱-۴). در این صورت:

حالت (۳)

$$E_1 = 1 + V/2, E_2 = 2 + V/2, E_3 = 3/5 + V/2, E_4 = 4$$

حالت (۴)

$$E_1 = 1 + V/2, E_2 = 2 + V/2, \\ E_3 = 3/5 + V/2, E_4 = 4 + V/2.$$

در حالت (۳) و (۴) نمودار $I-V$ ، سه‌پله‌ای و چهارپله‌ای می‌شود. متصل نبودن نقطه کوانتومی چهارم به الکترودها و در نتیجه تبدیل شدن آن به نقطه کوانتومی جانبی، موجب گیر افتادن الکترون در این نقطه و ایجاد اثر ضد تشدید هنگامی که $(m. L = V = E_4 = 4)$ است، می‌شود. این امر موجب افت جریان و ایجاد دره کوچک در نمودار $I-V$ و یک دره کوچک قبل از قله اصلی دوم در نمودار $G-V$ و باعث ناهمگونی کوچکی در توزیع هدایت می‌شود (شکل ۲ (الف) و (ب) (۳)).

مراجع

1. E Taranko, M Wiertel, and R Taranko, *J. Appl. Phys.* **111** (2012) 023711.
2. Z L He, D Zhang, P Li, J Y Bai, and Y F Bai, *Indian J. Phys.* **88** (2014) 6.
3. B B Brogi, S Chand and P K Ahluwalia, *Physica B: Condensed Matter* **461** (2015) 110.
4. H Rabani, M Mardani, and M Talebi, *Iranian Journal of Physics Research*, **15**, 1 (2015) 89.
۴. ح ربانی، م مردانی و م طالبی، مجله پژوهش فیزیک ایران، ۱۵، ۱ (۱۳۹۴) ۸۹.
5. J B Barner and S T Ruggiero, *Phys. Rev. Lett.* **59** (1987) 807.
6. M A. Reed, J N. Randall, R J Aggarwal, R J Matyi, T M Moore, and A Wetsel, *Phys. Rev. Lett.* **60** (1988) 535.
7. Y Q Feng, R Q Zhang, K S Chan, H F Cheung, and S T Lee, *Phys. Rev. B* **66** (2002) 045404.
8. C Shyam, R K Moudgil, and P K Ahluwalia, *Physica B: Condensed Matter* **405** (2010) 239.
9. D Weinmann, W H ausler, and B Kramer, *Phys. Rev. Lett.* **74** (1995) 984.
10. M Ciorga, M Pioro-Ladriere, P Zawadzki, P Hawrylak and A S Sachrajda, *Appl. Phys. Lett.* **80** (2002) 2177.
11. A Thielmann, M H Hettler, J K onig, and G Sch on, *Phys. Rev. B* **71** (2005) 045341.
12. M C Rogge, F Cavaliere, M Sassetti, R J Haug, and B Kramer, *New J. Phys.* **8** (2006) 298.
13. T C L G Sollner, P E Tannenwald, D D Peck, and W D Goodhue, *Appl. Phys. Lett.* **45** (1984) 1319.
14. Z Z Sun, R Q Zhang, W Fan, and X R Wang, *J. Appl. Phys.* **105** (2009) 043706.